(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-273691

(43)公開日 平成5年(1993)10月22日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 C	1/73	503	8910-2H		•
G 1 1 B	7/24	516	7215-5D		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

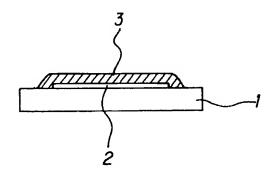
(21)出顧番号	特顯平468527	(71)出顧人 390014535
		新技術事業団
(22)出願日	平成 4 年(1992) 3 月26日	東京都千代田区永田町 2丁目 5番 2号
		(72)発明者 長村 利彦
		静岡県浜松市広沢 1 丁目23-3-13
		(72)発明者 小林 宏
		福岡県筑紫野市原695-18
		(72)発明者 園田 高明
		福岡県福岡市博多区光丘町 2 — 1 — 23
	•	(74)代理人 弁理士 田中 宏 (外1名)

(54) 【発明の名称】 光記録材料

(57)【要約】

【目的】 光の照射によって電荷移動を生ずる光誘起電 子移動反応に基づく光記録材料に関する。

【構成】 4,4'ービビリジニウムイオンとのイオン 対電荷移動錯体を含むポリマーからなる光反応膜上に酸 素透過率の小さい高分子膜を積層したことを特徴とする 光誘起電子移動反応に基づく光記録材料である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 4,4'-ビビリジニウムイオンとのイ オン対電荷移動錯体を含むポリマーからなる光反応膜上 に酸素透過率の小さい高分子膜を積層したことを特徴と する光誘起電子移動反応に基づく光記録材料。

【請求項2】 4、4'ービビリジニウムイオンとイオ ン対電荷移動錯体を形成する化合物が複数個のフルオロ 置換基を有するテトラフェニルボレートである請求項1 記載の光記録材料。

リジニウム・テトラキス〔3、5~ビス(トリフルオロ メチル)フェニル〕ボレート塩である請求項1記載の光 記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光記録材料に関し、特に 光の照射によって電荷移動を生ずる光誘起電子移動反応 に基づく光記録材料に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、光磁気ディスクなどに情報を書き 20 込む方法はレーザー光の熱によりディスク内に存在する 稀土類-遷移金属合金などの物質を変化させるもので所 謂ヒートモード記録と称せられる方法である。しかし、 ヒートモード記録では、その密度は、集光度によって殆 ど決まり、1平方でm当たり100メガ(1メガ=10 0万) ビット以上高密度に情報を記録させることが困難 であると云われている。そのため、光自体がもつ波長や 偏光の特性によって情報を記録しようとするフォトンモ ード記録が必要となってきた。すなわち、フォトンモー ド記録では多重化できるため大量の記録書き込みが可能 30 となるからである。そして、フォトンモード記録可能な 材料とは、光によって分子1個レベルの反応を起こす材 料であり、このような材料としては光化学ホールバーニ ング材料とフォトクロミック材料がある。

【0003】光化学ホールバーニング材料は分子の動き を凍結させた物質中に光によって反応する色素を分散さ せ、ある決まった波長のレーザ光をあてると光化学反応 により色素の分子構造が変化し、吸収スペクトルに小さ いホールができて、これを光記録に利用するもので、記 録密度は1cm²当たり100ギカ(1ギカ=10億)ビ 40 子膜を積層して酸化に対して保護した光記録材料であ ットと非常に大きい記録密度が得られるが、分子の動き を凍結させた中で光化学反応を行うため-196℃以下 という温度に冷却しなければ使用できないという欠点が あった。

【0004】一方、フォトクロミック材料は光により分*

し書き込みの耐久性及び書き込み速度などの点において 難点があった。ところで、4,4~~ビビリジニウムイ オンはカチオン性の電子受容体(アクセプター)として 多くの有機化合物又は無機アニオンと電荷移動(CT) 錯体を形成し、光励起状態ではドナーからアクセプター へ電子が1個移動する。本発明者は先に化学的に安定で 且つ嵩高な構造を有するテトラキス〔3,5ービス(ト リフルオロメチル)フェニル)ボレートアニオンと4, 【請求項3】 イオン対電荷移動錯体が4,4'-ビヒ 10 4'-ビビリジニウムイオンとがイオン対CT錯体を形 成し、脱気下で光を照射すると、光誘起電子移動を生じ 青色状態となり、暗所でかなりゆるやかに元の淡黄色状 態であるCT状態に戻り、再び光励起すると青色状態に なり、このような変化は何回も繰り返すことが可能であ ること、及び、この光誘起電子移動反応に基づく色変化

*子構造を変化して記録を可能にするものであるが、繰返

【0005】したがって、上記の現象に基づき4、4' -ビビリジニウムイオンとのイオン対電荷移動錯体を含 むポリマーは超高速書き込み可能な光記録材料として期 待されるが、該ボリマーは酸素などの酸化剤に対して大 きな反応性を有するため、大気中で上記の可逆的な色変 化を生ずることができない。

の速度がピコ秒オーダーの超高速で変化することを見出

[0006]

した。

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者は上 記の欠点を改良し、光記録材料として使用するため、種 々検討した結果、本発明を完成したもので、本発明の目 的は超高速度で書き込み可能な光誘起電子移動反応に基 づく光記録材料を提供するにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、4, 4'ービビリジニウムイオンとのイオン対電荷移動錯体 を含むポリマーからなる光反応膜上に酸素透過率の小さ い高分子膜を積層したことを特徴とする光記録材料であ る。すなわち、本発明は4、4'ービビリジニウムイオ ンをアクセプターとし、これに対するドナーと作用させ てイオン対電荷移動錯体を形成させ、得られた4.4' - ビヒリジニウムイオンのイオン対電荷移動錯体を含む ポリマーからなる光反応膜上に酸素透過率の小さい高分 る。本発明における4、4'ービビリジニウムイオンを 提供する化合物は下記の構造式(1)を有する化合物で ある。

[8000]

【化1】

$$R' - N + N - R^*$$
 (1)

チレンオキシド) 基である。本発明において、4,4' **-ビピリジニウムイオンとイオン対電荷移動錯体を形成** する化合物としては、4,4'-ビビリジニウムイオン に対してドナーとして作用する化合物であって、例え ば、複数個のフルオロ置換基を有するテトラフェニルボ*

【0011】式中、RはCF3, -CF2CF2CF2CF

【0014】などであって、Mは金属イオン又はアンモ 30 ニウムイオンを表す。

【0015】本発明において上記のイオン対電荷移動錯 体を含有するポリマーとしては、主鎖の一部に4.4' -ビビリジニウム基を有するポリ (テトラヒドロフラ ン) 又は側鎖に4,4'-ビピリジニウム基をもつビニ ルポリマー、又は低分子4,4'ービピリジニウム塩を 分散させたポリ (メチルメタクリレート)等である。分 散系の場合、該ポリマーに対して約20%程度の割合で 含有される。

【0016】また、本発明において使用する酸素透過率 40 の小さい高分子膜としてはポリビニルアルコール膜、ポ リ酢酸ビニル膜、ポリアクリロニトリル膜等である。主 鎖又は側鎖に4,4'ービビリジニウム基を有する高分 子の場合は、その多くの有機溶媒への高い溶解性のため に水溶性高分子保護膜を使用することが好ましい。

【0017】本発明にかかる光記録素の製造方法として は、ガラス、ポリカーボネート等の基板上に流延法によ り4、4~ービビリジウムイオンとのイオン対電荷移動 錯体を含むポリマーの膜、すなわち、光反応膜を成形

*レートで、具体的に二三を例示すると、下記に示すよう なテトラフェニルボレートがある。

[0010] 【化2】

※によって容易に得られる。

【0018】光反応膜の成形方法としては上記の4.

4'ービピリジウムイオンとその対イオンとして複数個 のフルオロ置換基を有するテトラフェニルボレートを含 有するポリマーの、例えば1,2ージメトキシエタン等 の有機溶液を作り、これを基板上にキャストしたり、或 20 はポリマー溶液中に4,4'ービピリジウムイオンを含 有するイオン対電荷移動錯体を溶解させた溶液を基板上 にキャストし、しかる後、その上にポリビニルアルコー ルなどの酸素透過率の小さい高分子を塗布、乾燥する。 使用する光反応膜形成溶液の濃度としては3 mg/ml 程度であり、またポリビニルアルコール水溶液の濃度と しては10mg/ml程度である。

【0019】得られた光記録素子を図示すると図1の通 りである。図中、1は基板、2は光反応膜、3は高分子 保護膜である。更に、実施例をもって本発明を具体的に 説明する。

[0020]

【実施例】

実施例 1

テトラヒドロフラン(24.45g)とトリフルオロメ タンスルホン酸無水物 (1.40g)を室温のアルゴン 雰囲気等で約15分撹拌した後−70℃に冷却する。そ こでテトラヒドロフラン10mlに溶かした0.53g の4,4'-ビビリジンを加えて数時間撹拌によって、 4,4'ービビリジニウム基を主鎖の一部に含むポリマ ーを作った。4,4'ービビリジウムイオン濃度は4. 3×10~4mol/gであった。このポリマーにテトラ キス〔3、5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル〕 ボレート塩を作用させてCT錯塩を得た。 次いで、こ のCT錯塩を1,2-ジメトキシエタンにとかし約0. 3%濃度の溶液をつくり、これをガラス基板上にキャス トして乾燥後光反応膜を形成した。続いてこの光反応膜 の上に濃度1%程度のポリビニルアルコール水溶液を塗 布し、乾燥して光記録材料を得た。得られた光記録材料 は空気中で光を照射すると青色に変化し、その寿命 (照 し、その上に酸素透過率の低い高分子膜を成膜すること※50 射直後の吸光度の1/e=1/2.718に減衰する時 間)は20℃で約70時間であった。比較のためポリビ ニルアルコール保護膜のないものは、空気中で光照射し ても色は変わらず、また脱酸素下で光照射して青色に変 化したものに空気を入れると約3分で色は消える。

【0021】実施例 2

ポリ (メチルメタクリレート) の1, 2-ジメトキシエ タン溶液(10mg/ml)1mlに5mgのN, N' ージメチルー4, 4' ーピピリジニウムのテトラキス [3,5-ピス(トリフルオロメチル)フェニル〕 ボレ 記録材料を得た。得られた光記録材料は空気中で光を照 射すると青色に変化し、その寿命 (照射直後の吸光度の 1/e=1/2. 718に減衰する時間) は20℃で約 45日であった。

[0022]

【発明の効果】以上述べたように、本発明は光反応膜と

してイオン対電荷移動錯体を使用したことにより光の照 射によって構造変化を伴うことなく単にイオン対間で電 子の移動によって可逆的に色の変化を示すのでくりかえ し書き込み可能な光記録材料を提供することができ、且 つイオン対電荷移動錯体として主鎖の一部に4,4'-ビビリシニウム基を含有するポリマーのテトラキス (3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル〕ボレ ート塩を使用したとき書き込み速度は数十ピコ秒程度と 迅速である。また、ポリビニルアルコール等の高分子膜 ート塩を溶かし、ガラス基板上にキャストして乾燥後光 10 を積層してあるので空気中で安定に記録状態を保持する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる光記録材料の断面図

- 1. 基板
- 2. 光反応膜
- 3. 保護膜

【図1】

